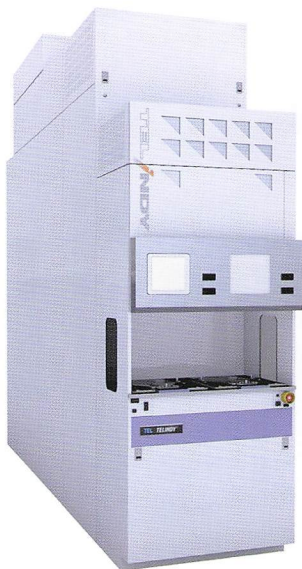


## 熱処理成膜装置

Thermal Processing System

# TELINDY PLUS™



### Features

- Batch ALD process to achieve high step coverage and high productivity ● バッチ式ALDによりカバレッジ性能の確保と高生産性を両立
- Seed technology to achieve thin film controllability ● シード技術によるCVD膜の薄膜制御性の向上
- High speed robotics ● 高速搬送メカ
- Dry cleaning technology for particle reduction ● ドライクリーニング技術による微小パーティクル制御
- 31% reduction of energy consumption per wafer by decreasing L/L N<sub>2</sub> flow rate and by higher throughput (SEMI S23 conversion, compared to TELINDY™) ● L/L N<sub>2</sub>流量削減、スループット向上によりウェーハ当たりのエネルギー消費量31%削減 (SEMI S23換算、TELINDY™比)

### Applications

- Oxide/Anneal/CVD/ALD ● 成膜装置 (酸化/アニール/CVD/ALD装置)

磁場中熱処理装置は、当社のウェブサイトにてご紹介しています  
For magnetic annealing, please visit

[www.tel.com/product/spe/tps](http://www.tel.com/product/spe/tps)

## ALD装置

Atomic Layer Deposition System

# NT333™



### Features

- Thickness controllability at the monolayer level through sufficient gas adsorption and oxidation ● 反応ガスの十分な吸着・酸化による原子レベルでの膜厚制御
- High quality film deposition by taking quality improvement steps into ALD cycles ● ALDサイクル内への改質ステップ組み込みによる高品質成膜の実現
- SiO<sub>2</sub> film deposited in low temperature regions (<400°C) has comparable HF etch resistance and leakage performance to thermal oxide ● 低温域(400度以下)において熱酸化膜同等の耐フッ酸性、リーク特性の実現
- Enabling excellent film property uniformity required for high aspect ratio structures on 3D NAND devices at high temperatures (760°C) ● 高温域(760度成膜)において3D NANDに求められる高アスペクト内の膜厚均一性を達成

### Applications

- Various Dielectric Films-Thermal Plasma Configuration ● 高品質ALD Film

磁場中熱処理装置は、当社のウェブサイトにてご紹介しています  
For magnetic annealing, please visit

[www.tel.com/product/spe/tps](http://www.tel.com/product/spe/tps)